Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0200U003139

Державний реєстраційний номер: 0198U002349

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-03-2000

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка напівпровідникових сенсорів фізичних величин на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію і германію

Початок етапу: 01.1998

Закінчення етапу: 12.1999

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 744300

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка напівпровідникових сенсорів фізичних величин на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію і германію

Назва роботи англійською:

Development of semiconductor physical sensors based on silicon-on-insulator structures and silicon and germanium microcrystals

Реферат українською:

Проведено дослідження впливу деформації, температури, магнітного поля, опромінення (лазерного та електронного) на властивості шарів полікремнію-на-ізоляторі та мікрокристалів (МК) кремнію та германію. Розроблено високочутливі сенсори великих деформацій, високотемпературні високочастотні сенсори тиску, температурно стабільні сенсори тиску на основі КНІ-структур, сенсори для медичної діагностики та ін. Показано можливість створення сенсорів на основі (МК) Si і Ge для роботи при кріогенних температурах в сильних магнітних полях та сенсорів теплових величин на основі ефекту Зеебека.

Реферат англійською:

Investigation of strain, temperature, magnetic field and radiation (laser and electronic) influence on the properties of poly-Si layers-on-insulator and Si and Ge microcrystals (MC) was carried out to develop physical sensors. High-sensitive sensors to measure high strains, high-temperature pressure sensors, pressure sensors with high thermostability, sensors for medical diagnostics were created. The possibility of creation sensors on the basis of Si and Ge MC for operating at cryogenic temperatures and high magnetic fields and thermal snsors based on Seebeck effect was shown.

Індекс УДК: 681.121./123; 532.57, 531.787

Коди тематичних рубрик: 59.37.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дружинін А.О.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Рильніков Борис Сергійович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

